PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-066879

(43)Date of publication of application: 10.03.1998

(51)Int.CI.

B01J 35/02 B01J 23/14 B01J 23/42 B01J 23/44 B01J 23/72 B01J 23/755 C23C 14/06

(21)Application number: 08-247308

(71)Applicant: BRIDGESTONE CORP

(22)Date of filing:

29.08.1996

(72)Inventor: YOSHIKAWA MASAHITO

NOGUCHI TOMOKO

(54) PHOTOCATAYST

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the decrease in the crystallinity and orientation of a photocatalyst and to improve catalytic activity by mixing metal or metal oxide which improves the photocatalytic activity into the photocatalyst of metal oxide indicating phtocatalytic activity.

SOLUTION: A photocatalyst which is used for the purification water and air, deodorization, etc., is prepared by mixing metal or metal oxide which improves the phtocatalytic activity of metal oxide into metal oxide indicating photocatalytic activity. In this process, the photocatalyst of a metal oxide film is formed preferably by sputtering using a metal oxide target in which the metal or the metal oxide which improves the photocatalytic activity of the metal oxide is incorporated into the metal oxide indicating photocatalytic activity. As the metal oxide indicating photocatalytic activity, for example, TiO2, ZnO, WO3, etc., are used appropriately, and as the metal or the metal oxide which improves the photocatalytic activity of the metal oxide, for example, platinum, palladium, nickel, copper, tin, tin oxide, etc., are named.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.01.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開平10-66879

(43)公開日 平成10年(1998)3月10日

(51) Int. C1. 6	識別記号	庁内整理番号	FΙ				技術表示箇所
B01J 35/02			B01J 35/02			j	
23/14			23/14			M	
23/42			23/42			M	,
23/44			23/44			M	
23/72			23/72		M		
		審査請求	未請求 請求	項の数 4	F D	(全4頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平8-247	(71)出願人	0000	0 5 2	7 8		
				株式会社	ブリヂ	ストン	
(22)出願日	平成8年(199	:(1996)8月29日 東京都中央区京橋1丁目10番1号				0番1号	
	•		(72)発明者	吉川 雅	人		
			1	東京都小	平市上	水本町3-	16-15-1
				0 2			
			(72)発明者	野口 智子			
•				東京都小	平市小	川東町3-:	3 - 6 - 3 1 0
			(74)代理人	弁理士	小島	隆司 (外:	1名)
****			т .				

(54) 【発明の名称】光触媒

(57)【要約】

【解決手段】 光触媒活性を示す金属酸化物に、該金属 酸化物の光触媒活性を向上させる金属又は金属の酸化物 を混入してなることを特徴とする光触媒。

【効果】 本発明の光触媒は、光触媒活性を示す金属酸 化物に、その触媒活性を向上させる異種金属又は異種金 属の酸化物を混入させて、光触媒の光触媒活性を向上さ せたものであり、例えばガラス等のアモルファスな材料 からなる基材上に成膜した場合、光触媒の膜厚が薄いも のであっても高い光触媒活性が得られる。ここで、この ような光触媒を基材上に成膜する場合、ターゲット中に 異種金属又は異種金属酸化物を混入してスパッタリング 又はリアクティブスパッタリングを行うスパッタリング 法により好適に成膜することができる。

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光触媒活性を示す金属酸化物に、該金属酸化物の光触媒活性を向上させる金属又は金属の酸化物を混入してなることを特徴とする光触媒。

【請求項2】 光触媒活性を示す金属酸化物に、該金属酸化物の光触媒活性を向上させる金属又は金属の酸化物を混入した金属酸化物ターゲットを用いて、スパッタリングを行うことによって得られる請求項1記載の光触媒。

【請求項3】 光触媒活性を示す金属酸化物に対応する金属に該金属酸化物の光触媒活性を向上させる金属を混入した金属ターゲットを用いて、酸素分子を有するガスを含有する不活性ガス中でリアクティブスパッタリングを行うことによって得られる請求項1記載の光触媒。

【請求項4】 金属酸化物の光触媒活性を向上させる金属又は金属の酸化物が白金、パラジウム、ニッケル、銅、スズ及び酸化スズから選ばれる1種又は2種以上である請求項1、2又は3記載の光触媒。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、水浄化、空気浄化、消臭、油分の分解等に有効に用いられる光触媒に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来、 TiO,, ZnO, WO,, Fe,O,, SrTiO,等の 金属酸化物が光触媒として水浄化、空気浄化、消臭、油 分の分解などに広く使用されている。このような光触媒 は、通常粉末状で用いられている。この粉末状の光触媒 を固定化するためには、例えば粉末にパインダーとして 30 樹脂やゴムなどを混ぜて練り、それを基材に塗って数百 ℃で焼結させるパインダー固定法がある。また、光触媒 を基材に膜状に密着させる方法として金属アルコキシド 溶液を用いてゲルコーティング膜を作成し、それを数百 ℃で加熱するゾルーゲル法で得た金属酸化物膜を光触媒 に用いることも知られている。しかし、パインダー固定 法もゾルーゲル法も、上述したように金属酸化物膜の作 成時に高温で加熱するため、耐熱性の基材しか用いるこ とができない。一方、スパッタリング法により得られる 金属酸化物膜を光触媒として用いれば、基材の種類を選 40 ばないで光触媒膜がコーティングされた光触媒体を得る ことができるが、この場合であっても、例えば基材にガ ラスなどのアモルファス (無定形、非晶質) な材料を用 いた場合、光触媒の膜厚が薄い程、基材の影響を受けて その結晶性や配向性が悪くなり、光触媒の触媒活性が低 下する可能性が生じる.

【0003】本発明は上記事情に鑑みなされたもので、 触媒活性が良好な光触媒を提供することを目的とする。 【0004】

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】本 50 の場合、これらのターゲットとして上記金属酸化物の光

発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討を行った 結果、光触媒活性を示す金属酸化物からなる光触媒に、 その光触媒活性を向上させるような金属又はそのような 金属の酸化物を混入させることによって、光触媒の結晶 性や配向性の低下が防止されて、その触媒活性が向上す ることを知見し、本発明をなすに至った。

【0005】従って、本発明は、(1)光触媒活性を示す金属酸化物に、該金属酸化物の光触媒活性を向上させる金属又は金属の酸化物を混入してなることを特徴と属酸化物の光触媒活性を示す金属酸化物に該金属酸化物の光触媒活性を向上させる金属又は金属の酸化物を混入した金属酸化物ターゲットを用いて、スパッタリングを行うことによって得られる上記金属又は金属の粉化物が混入した金属酸化物時の大触媒活性を示す金属酸化物に対応する金属化物の光触媒活性を向上させる金属を混入を含有する不活性ガス中でリアクティブスパッタリングを行うことによって得られる上記金属又は金属の酸化物が混えした金属酸化物膜からなる上記(1)の光触媒を提供する。

【0006】以下、本発明につき更に詳述すると、本発 明の光触媒は、上述したように、光触媒活性を示す金属 酸化物に、その光触媒活性を向上させる金属(異種金 属)又は異種金属の酸化物を混入したものである。ここ で、光触媒活性を示す金属酸化物としては、例えばTi O,, ZnO, WO,, Fe,O,, SrTiO,等が好適 に用いられる。また、異種金属及び異種金属の酸化物と しては、上記金属酸化物の光触媒活性を向上させるもの であれば、その種類は特に制限されないが、このような 金属又は金属の酸化物として、例えば白金、パラジウ ム、ニッケル、銅、スズ、酸化スズ等が挙げられ、これ らは、1種単独で又は2種以上を適宜組み合わせて使用 することができ、これらの中でも、特に光触媒活性の向 上効果に優れる白金、パラジウム、ニッケルが好適に使 用される。ここで、これらの異種金属又は異種金属の酸 化物の混入率としては、光触媒全体に対して 0.01~ 20重量%、特に0.1~10重量%とすると好適であ る。混入率が低すぎると異種金属等の混入の効果が十分 に得られず、高すぎると光触媒と被分解物の接触面積が 減少する場合がある。

【0007】本発明の光触媒は、公知のスパッタリング 法等の方法によって基材上に成膜することができるが、 光触媒活性を示す金属酸化物をターゲットとしてスパッ タリングを行うスパッタリング法、又はそのような金属 酸化物に対応する金属をターゲットとして、酸素分子を 有するガス(酸化性ガス)を含有する不活性ガスの存在 下でリアクティブスパッタリングを行うリアクティブス パッタリング法が特に好適に採用され、本発明の光触媒

触媒活性を向上させる金属(異種金属)を混入させたも のを用いることにより、異種金属又は異種金属の酸化物 が混入した光触媒を得ることができる。

【0008】即ち、例えば高周波スパッタリング法のよ うに光触媒活性を示す金属酸化物ターゲットをスパッタ リングして成膜する際には、上記金属酸化物ターゲット 中に異種金属又は異種金属酸化物を混入し、成形したも のをターゲットとして用いる。一方、例えば光触媒活性 を示す金属酸化物に対応する金属を酸化性ガス雰囲気中 で酸化させながら成膜するリアクティブ直流 (DC)ス 10 パッタリング法の場合には、上記金属ターゲット中に異 種金属を混ぜ込み、成形したターゲットを使用する。な お、本発明の場合、スパッタリングにより得られた金属 酸化物膜を光触媒とすると好適であるが、スパッタリン グの手段は特に限定されるものではなく、具体的にはR Fスパッタリング、DCスパッタリング、マグネトロン スパッタリング、対向スパッタリング、イオンピームス パッタリング等種々の手段を採用することができる。

【0009】本発明のターゲットとして用いられる金属 酸化物は、上述したように光触媒括性を示し、MeO、 (MeはFe, W, SrTi, Ti, Zn等の金属を示 ・し、xは金属の種類によって異なるが、0~10、好ま しくは0~5の範囲の正数であり、xは必ずしも金属の 価数に相当していなくともよい)で示される金属酸化物 であり、特には光触媒として優れたTiOi, ZnO, WO, Fe,O, SrTiO, 等である。一方、金属タ ーゲットの場合、所望する光触媒活性を示す金属酸化 物、即ち上記MeO.に対応した金属であり、特には光 触媒として優れたTiO,, ZnO, WO,, Fe,O,, SrTiO,等に対応した金属である。

【0010】本発明において混入される異種金属又は異 種金属の酸化物としては、上述したように特に光触媒活 性の向上効果に優れると共に、混入後にターゲットとし て成形することが可能な白金、パラジウム、ニッケル、 銅、スズ、酸化スズが好適に使用される。なお、これら の異種金属のターゲット全体に対する混入率は上記の光 触媒全体に対する混入率と同様である。

【0011】また、本発明においては、真空、不活性ガ ス又は酸化性ガスを含有する不活性ガスの存在下で上記 異種金属又は異種金属酸化物を混入した金属酸化物ター 40 ゲット又は金属ターゲットにより金属又は金属酸化物を 異種金属と共にスパッタさせ、所望の基材上に異種金属 又は異種金属の酸化物が混入した金属酸化物膜を形成す るものであるが、スパッタリング用の不活性ガスとして は、ヘリウム、アルゴン等が用いられ、特に工業的に安 価なアルゴンが好ましい。一方、上記酸化性ガスとして は、酸素、オゾン、空気、水等が挙げられ、通常は酸素 が用いられる。なお、上記不活性ガスと酸化性ガスとの 流量比 (容量比) は適宜選定されるが、不活性ガス:酸 化性ガス=100:0.1~100:1000の範囲と 50 成した。また、比較例では、ターゲット中にPtを加え

することが好ましい。なお、スパッタリング時の圧力は 高真空下から大気圧下とすることができるが、通常1m Torr~lTorrの真空下で行われる。

【0012】ここで、上記基材は、その種類が特に制限 されるものではなく、例えばポリメチルメタクリレー ト、ポリカーボネート、シリコーン、ポリスチレン等の プラスチック材、ポリエステル系、ポリアミド系、ポリ ピニルアルコール系などの合成繊維、天然繊維、半合成 繊維等からなる織布又は不織布などの有機系材料やガラ ス、石英、セラミックス、シリカ等の無機質材料及びア ルミ、ステンレス等の金属材料などの無機系材料を使用 することができる。

【0013】なお、本発明において、スパッタリング装 置、リアクティブスパッタリング装置、スパッタリング 圧力等のスパッタリング条件などは特に制限されず、公 知の装置、条件を採用することができる。例えば、DC マグネトロンスパッタリング、対向スパッタリングなど の装置を用いることができる。

【0014】本発明の光触媒は、公知の光触媒と同様に 20 して使用することができ、例えばこの光触媒に光を照射 することによって光触媒が励起し、殺菌、脱臭等の作用 を発揮するもので、水浄化、空気浄化、消臭、油分の分 解などに用いることができるものであるが、ここで、本 発明の場合、混入した異種金属、異種金属酸化物の存在 により、光触媒の光触媒活性を向上させることができ る.

[0015]

【発明の効果】本発明の光触媒は、光触媒活性を示す金 属酸化物に、その触媒活性を向上させる異種金属又は異 種金属の酸化物を混入させて、光触媒の光触媒活性を向 上させたものであり、例えばガラス等のアモルファスな 材料からなる基材上に成膜した場合、光触媒の膜厚が薄 いものであっても高い光触媒活性が得られる。ここで、 このような光触媒を基材上に成膜する場合、ターゲット 中に異種金属又は異種金属酸化物を混入してスパッタリ ング又はリアクティブスパッタリングを行うスパッタリ ング法により好適に成膜することができる。

[0016]

【実施例】以下、実施例及び比較例を示し、本発明を具 体的に説明するが、本発明は下記の実施例に制限される ものではない。

【0017】 (実施例, 比較例) 光触媒の作製法とし て、実施例では無アルカリガラス板(コーニング社製、 7059) の基材の30mm×40mmの面に対し、そ れぞれマグネトロンスパッタリング法(ターゲット T i+Pt)で、酸化用ガスとして酸素10ml/分をア ルゴンガス10ml/分とともにスパッタ装置内に流 し、ガス圧5mTorr、ターゲット投入パワー1.2 kWで60分成膜を行って、3000Åの光触媒膜を形 (4)

特開平10-66879

5

ない以外は実施例と同様にして成膜を行った。

【0018】 これらの光触媒を、トリクロロエチレン1 0ppmを含む30mlの水中に浸し、500W超高圧 水銀灯(300nm以下をカット)を照射した。 を測定し、比較例のトリクロロエチレンの分解能力を100として相対評価を行った。結果を表1に示す。

【0020】 【表1】

【0019】照射60分後のトリクロロエチレンの濃度

	比較例	実 施 例			
	儿叔两	1	2	3	
Pt 含有量(ターゲット中の <u>重量</u> %)	0	0.3	3	10	
分解能力	100	150	180	200	

表1によれば、本発明の光触媒は異種金属の混入によ

り、その触媒能力が向上することが認められる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

23/755

C23C 14/06

B01J 23/74

321

C23C 14/06